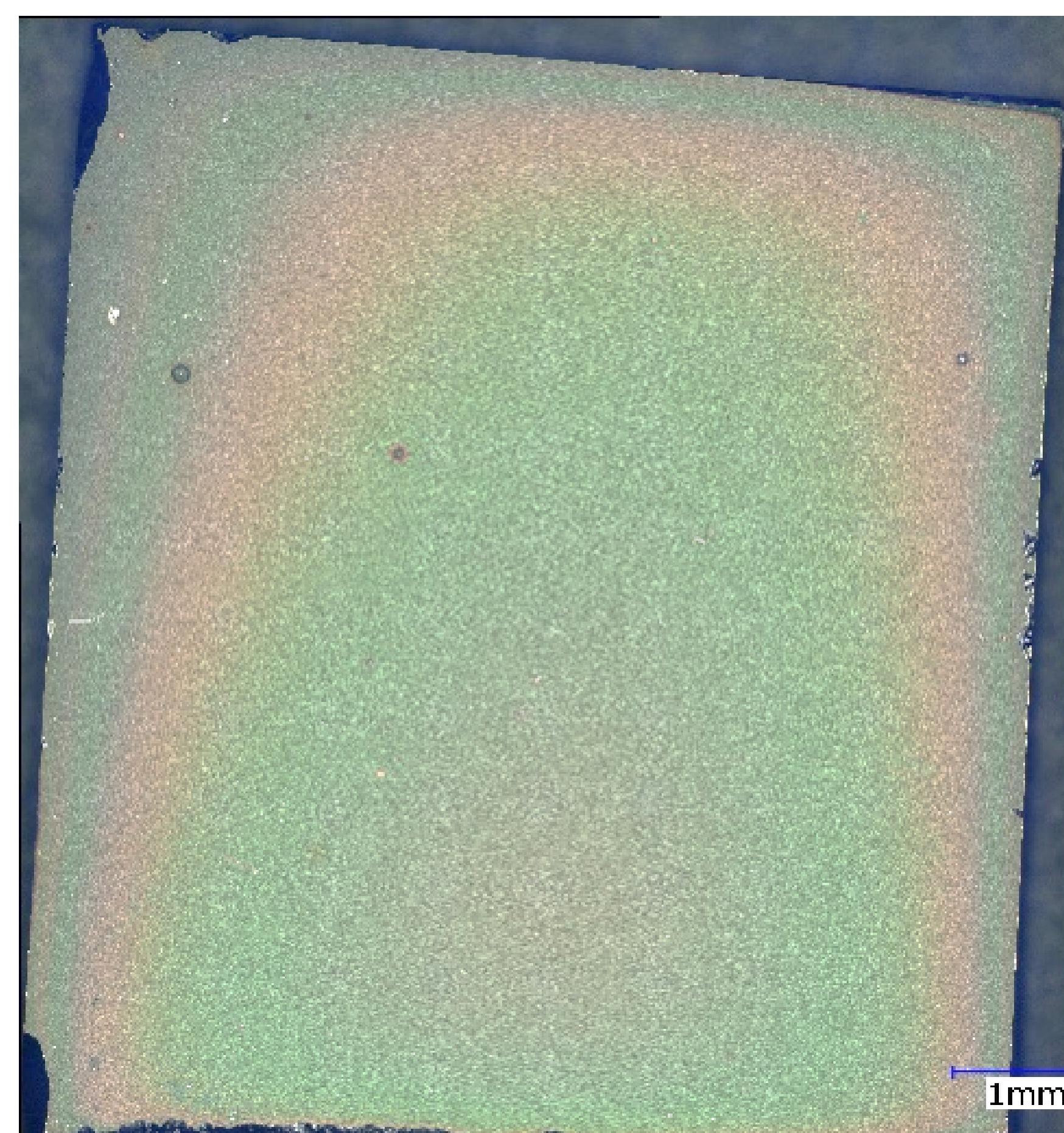


立命館大学発ベンチャー



PATENTIX



Si(100)基板上の導電性バッファー層上に成膜されたr-GeO₂の外観写真

「世界初」
Si基板上への
r-GeO₂薄膜の作製に成功。

～次世代半導体材料r-GeO₂を安価に実現する道を拓く～